シリコン表面の局所的な応力場におけるサーモリフレクタンス信号の位相分布

神戸市立工業高等専門学校 三宅修吾



Fig.1 サーモリフレクタンスの原理と位相信号.



Fig. 2 ナノインデンテーションにより付与された単結晶シリコン表面の塑性変形(a)と顕微サーモリフレクタンス信号の位相分布 (b).

サーモリフレクタンス(TR)法とは Fig.1に示す様に,強 度変調した加熱光と一定強度の検出光を測定部に照射した際 に生じる,反射された検出光信号(サーモリフレクタンス信 号)の位相解析を行う事で,薄膜材料やマイクロスケールに 迫る局所的な熱物性が評価できる手法である<sup>(1)(2)</sup>.光検出器 とロックインアンプで解析される TR 信号の位相は,主に加 熱光の熱拡散長程度の測定部近傍と表面直下の熱伝播特性に 支配される.すなわち材料表面に施された加工や変形により 格子ひずみや結晶性の乱れが生じた場合,TR 信号の位相は 無ひずみの状態と比べて相対的に変化する.この原理を基に 単結晶シリコン表面にナノインデンテーションで1辺が5 µm 程度の微小な塑性変形を与えた試料を用意し,圧痕周辺 の TR 信号の位相分布を測定した<sup>(3)</sup>.

**Fig. 2**(a)に TR 信号計測用に施した厚さ100 nm の Mo 膜 を介して圧痕表面を光学顕微鏡で撮影した写真を示す. Mo 膜の影響でコントラストは弱いが, 圧痕頂点から放射状にク ラックが発生している事がわかる. Fig. 2(b)には同一領域 における TR 信号の位相分布を示す. 圧痕頂点付近と圧痕各 辺に垂直な方向において, 位相分布の大きな違いが認められ る. この TR 信号の位相分布は顕微ラマン分光法によるラマ ンシフトの分布と傾向が一致していた事から, 応力場の情報 を反映していると考えられる.本法は表面に反射膜を施す事 で金属材料以外にも高分子やセラミックス材料まで幅広く適 用できるだけでなく, 加熱周波数を走査することで情報領域 も制御できる事から, 今後は様々な材料への展開が期待され る.

## 文 献

- (1) S. Miyake, T. Kita, A. Miyake, K. Ikeda, and H. Takamatsu: Rev. Sci. Instrum., **80**(2009), 124901.
- (2) 三宅修吾,三宅 綾,池田健一,高松弘行,喜多 隆:日本 金属学会誌,73(2006),434-438.
- (3) S. Miyake, T. Kato, H. Taguchi and T. Namazu: Jpn. J. Appl. Phys., **55** (2016), 06GP08.

<sup>(2018</sup>年8月10日受理)[doi:10.2320/materia.57.596]

Phase Distribution of Thermoreflectance Signal Around Local Stress on Silicon Surface; Shugo Miyake Keywords: *frequency-domain thermoreflectance method, single crystal silicon, local stress* Specimen preparation: DC sputtering (Mo target) TR measurement: TM3 (Bethel Co., Ltd.)